

(11)Publication number:

2002-317231

(43) Date of publication of application: 31.10.2002

(51)Int.CI.

C22C 9/06 G11B 5/60 G11B 21/21 // H01B 1/02

(21)Application number: 2001-071938

(71)Applicant: NIPPON MINING & METALS CO LTD

(22) Date of filing:

14.03.2001

(72)Inventor: TOMIOKA YASUO

MAKI TETSUO

ERA NAOHIKO

(30)Priority

Priority number: 2000070152

Priority date: 14.03.2000

Priority country: JP

2001038465

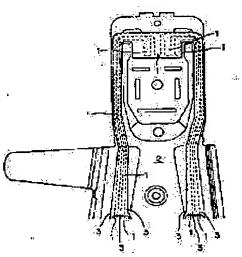
15.02.2001

JP

(54) COPPER ALLOY FOIL FOR HARD DISK DRIVE SUSPENSION

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To increse the positioning precision of a hard disk driven suspension of a computer. SOLUTION: The copper alloy foil has a composition containing 1 to 4.8% Ni and 0.2 to 1.4% Si, and in which the ratio of the Ni content to the Si content is controlled to 2 to 8, and the balance substantially copper with inevitable impurities, and has tensile strength of ≥650 MPa. The dimensions of inclusions are ≤10 µm, and also, the number of inclusions having the dimensions of 5 to 10 μ m is ≤ 50 pieces/mm2 in the cross-section parallel to the rolling direction. Further, provided that the percentage of constraction by heat? before and after heating at 330° C for 2 hr equivalent to heating conditions on thermalcompression bonding with a polyimide is defined as ? (%)=(I-10)/ 10×100 ; wherein, 10 is the length of the sample before the heating, and I is the length of the sample after the heating,? satisfies -0.1% to +0.1% to the direction parallel to the rolling direction.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22.03.2001

[Date of sending the examiner's decision of

07.10.2003

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Date of extinction of right]

[Patent number] 3539685
[Date of registration] 02.04.2004
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's 05.11.2003 decision of rejection]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-317231 (P2002-317231A)

(43)公開日 平成14年10月31日(2002.10.31)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコート*(参考)
C 2 2 C	9/06		C 2 2 C	9/06		5 D 0 4 2
G11B	5/60		G11B	5/60	P	5D059
	21/21			21/21	С	5 G 3 O 1
// H01B	1/02		H 0 1 B	1/02	Α	

審査請求 有 請求項の数3 OL (全 7 頁)

(21)出願番号	特願2001-71938(P2001-71938)	(71)出願人	397027134
			日鉱金属株式会社
(22)出顧日	平成13年3月14日(2001.3.14)		東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
		(72)発明者	宮岡 靖夫
(31)優先権主張番号	特顏2000-70152(P2000-70152)		茨城県日立市白銀町一丁目1番2号 日鉱
(32)優先日	平成12年3月14日(2000.3.14)		金属株式会社技術開発センター内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	牧 哲生
(31)優先権主張番号	特顧2001-38465 (P2001-38465)		茨城県日立市白銀町一丁目1番2号 日鉱
(32)優先日	平成13年2月15日(2001.2.15)		金属株式会社技術開発センター内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(74)代理人	100077528
			弁理士 村井 卓雄

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ハードディスクドライブサスペンション用銅合金箔

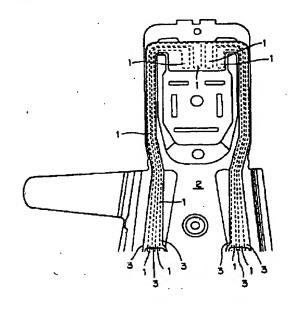
(57)【要約】

【課題】 コンピュータのハードディスクドライブサスペンションの位置決め精度を高める。

【解決手段】Ni: $1\%\sim4.8\%$, Si: $0.2\%\sim1.4\%$ とし、Siに対するNiの含有量比が $2\sim8$ になるように調整し、残部を実質的に銅及び不可避不純物とし、引張強さが650MPa以上、介在物の大きさが 10μ m以下であり、かつ $5\sim10\mu$ mの大きさの介在物個数が圧延平行断面で50個/mm 以下とし、さらにボリイミドと熱圧着する際の加熱条件に相当する330°C、2時間の加熱前後における熱伸縮窓 Δ を

 Δ (%) = (1-1,) /1, ×100

1。: 加熱前の試料長さ、 1: 加熱後の試料長さ としたとき、圧延平行方向に対して Δ が-0.1% である銅合金箔。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 添加元素の成分を、質量割合にて、N $i:1\%\sim4.8\%$, S $i:0.2\%\sim1.4\%$ とし、S i に対するN i の含有量比が $2\sim8$ になるように調整し、残部を実質的に銅及び不可避不純物とし、引張強さが650MPa以上、介在物の大きさが 10μ m以下であり、かつ $5\sim10\mu$ mの大きさの介在物個数が圧延平行断面で50個/mm²以下であり、さらにポリイミドと熱圧着する際の加熱条件に相当する330°C、2時間の加熱前後における熱伸縮率 Δ を Δ (%)= $(1-1_0)/1_0 \times 100$

1。: 加熱前の試料長さ、 1: 加熱後の試料長さ としたとき、圧延平行方向に対して Δ が-0.1%~+0.1%であるハードディスクドライブサスペンション用銅合金 箔。

【請求項2】 添加元素の成分を、質量割合にて、N $i:1\%\sim4.8\%$, S $i:0.2\%\sim1.4\%$, Mg, Zn, Sn, F e, Ti, Zr, Cr, Al, Mn, AgもよびBeの1種以上を総量で $0.005\sim2\%$ とし、S i に対するN i の含有量比が $2\sim8$ に なるように調整し、残部を銅及び不可避不純物とし、引 張強さが650MPa以上,介在物の大きさが 10μ m以下であ 20 り、かつ $5\sim10\mu$ mの大きさの介在物個数が圧延平行断面 で50個/mm³以下であり、さらにポリイミドと熱圧着する際の加熱に相当する330°C、2時間の加熱前後における熱 伸縮率 Δ を

 Δ (%) = (1-1,) /1,×100

1。: 加熱前の試料長さ、 1: 加熱後の試料長さ としたとき、圧延平行方向に対して Δ が-0.1%~+0.1% であるハードディスクドライブサスペンション用銅合金 箔。

【請求項3】 ポリイミドと熱圧着する際の加熱に相当する330℃, 2時間の加熱前後における熱伸縮率△が、前記範囲の値に加えて、圧延直角方向において-0.02%~+0.04%である請求項1または2記載のハードディスクドライブサスペンション用銅合金箔。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ハードディスクドライブのサスペンション上の配線に用いられ、高速信号 伝達が可能な高強度高導電性銅合金箔に関するものである。

[0002]

【従来の技術】コンピューターの記憶装置として用いられるハードディスクドライブにおいて、磁気ディスクの情報を読む磁気へッドを支持するために、ステンレス鋼製の薄板を加工したサスペンションが腕として用いられ、磁気へッドはこのサスペンションの先端に取りつけられる。磁気ディスクの情報を読み取るときや、情報を書き込む時には、サスペンションの根元を軸としてサスペンションが回転するととによって、磁気ヘッドが磁気ディスクの所定位置まで移動し、信号のやり取りを行

う。近年のハードディスクドライブには、記憶容量の向上、信号伝達の高速化、小型化、高い信頼性が求められる。これに伴い、サスペンションおよび磁気へッドを含めた系には、高密度配線、高い位置精度、高い電気伝導性が要求される。ちなみに現在のハードディスクのトラック幅は2μmであり、磁気ヘッドの位置決めは0.2μπ以下の精度で行われている。

【0003】図1は、ハードディスクドライブサスペンションの先端平面図である。ハードディスクドライブの磁気10 ヘッドを支持するサスペンション上に配線するために、従来は導線が用いられていた。しかしながら、位置精度、結線、取り扱いの容易性、製造コスト等の観点で、厚さ18μm程度の銅合金箔1の配線がポリイミド等の樹脂3を介してサスペンション2上に接着されたものが用いられるケースが増えてきた。

【0004】とのようなサスペンション部品の製造されるプロセスは次の通りである。まずボリイミドを介して銅合金箔と、一般に厚さが0.020mm前後のステンレス鋼(SUS304など)の基板を熱圧着した3層の積層シートを製造する。次に積層シートをエッチング加工するとにより銅合金箔、ステンレス鋼などの基板、ポリイミドの所定部分を除去し、所定の形状と配線構造を持つサスペンション部品が得られる。エッチングは銅合金箔側とステンレス鋼基板側の両方から行われる。エッチング後の部品は、ステンレス鋼基板を除去したポリイミド、個間とステンレス鋼工層積層体及び銅合金箔ーポリイミドカニアンレス鋼工層積層体及び銅合金箔ーポリイミドステンレス鋼工層積層体及び銅合金箔ーポリイミドステンレス鋼基板の三層積層体が共存するととになる。

- 0 【0005】この配線に用いられる箔に要求される性質は次の通りである。まず、積層シートの製造工程、エッチングによるサスペンションの製造工程、さらにヘッド部の組立工程を通じて、折れなどの変形を生じないように、高い強度が必要とされる。また、積層シートを製造する際の熱圧着時に生じる銅合金箔の熱伸縮が、ボリイミドやステンレス鋼などの基板の寸法変化とマッチングしないと積層シート製造時または続くエッチング加工後に反りを生じるためハードディスクサスペンション機構のアームの寸法精度に支障をきたす。
- 40 【0006】ところで、Cu-Ni-Si系合金を電気・電子部品に使用することは公知である。特許第2651122号にて提案された電気・電子部品用Cu-Ni-Si系合金の製造方法は、Ni:4.1~10wt%, Si:1.0~1.5wt%, Mn:0.2wt%以下、Zn:1.0%以下を含有し、S含有量が15ppm以下であり、残部がCuと不可避的不純物とからなる銅合金の製造方法に関するものであるが、950~1000℃に1分以上保持する溶体化処理を施した後、少なくとも300~600℃の温度範囲を10℃/sec以上の冷却速度で冷却し、50%以上の加工率で冷間圧延後、450~550℃の温度で、1~30分熱処理を行い、その後30~80%の加

3

工率で冷間加工後、380~440℃の温度で5~180分熱 処理を行う方法である。との方法において、450~550 °Cの前段熱処理と380~440°Cの後段熱処理の2段熱処理 を行うのは、高温の前段熱処理では析出を進行させ、再 結晶を起こさせ、低温の後段熱処理では微細析出物を形 成して強度及び導電率を向上させるためである。さら に、各熱処理の前に冷間加工を行う理由は、1回目の熱 処理前の冷間加工、との熱処理での再結晶を促進するた めであり、また2回目の熱処理前に冷間加工を行うの は、加工硬化とこの熱処理での再結晶を促進するためで 10 ある。さらに、記述されている特性は引張り強さ、伸 び、導電率であり、熱膨張率や熱収縮などについては記 述されていない。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明者らは、加熱に より、銅合金箔、ステンレス鋼基材、ポリイミドなどが どのように伸縮するかを研究した。その結果、銅合金箔 とステンレス鋼の熱伸縮は非可逆的に起こることを見出 した。即ち、加熱・冷却のサイクルにより最初の温度に 戻ったとき、これらの材料は加熱サイクルの前の寸法に 20 は戻らず、収縮する場合と膨張する場合がある。そし て、さらに研究した結果、銅合金の非可逆的寸法変化は 圧延加工によって導入された格子欠陥が加熱により消失 する過程が関係していることを究明した。

【0008】理想的には、ハードディスクサスペンショ ンの配線構造を作る銅合金箔、ステンレス鋼基材、ポリ イミドなどの三者が同じように熱伸縮すれば、反りなど は発生しない。実際はこれらが同一ではないので、三層 を積層した状態では各層の歪がバランスし反りがなくと も、エッチングした段階で歪のバランスが崩れ長手方向 30 の反りが発生する。近年の磁気ヘッドのように高い位置 精度を必要とするハードディスクドライブサスペンショ ンでは、僅かでも反りが発生すると、トラッキング性能 が不良となった。よって、高い位置精度を得るために は、銅合金箔の熱伸縮をステンレス鋼及びポリイミドと マッチングするように精密にコントロールする必要があ ることが分かった。さらに、生産性の観点から、サスペ ンション部品の長手方向を圧延直角方向にとるケースが 多いことから、圧延平行方向だけの寸法変化をコントロ ールするだけでは不十分であり、同時に圧延直角方向の 熱伸縮をコントロールしないとサスペンション部品にそ りが生じる場合があることが分かった。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記目的 を達成すべく鋭意検討を行った過程で、髙強度をもつ銅 合金に着目し、これらを損なうことなく、ハードディク サスペンション配線構造の寸法変化が厳密に制御され, エッチング性の良好な銅合金箔を実現できるに至った。 さらに、 析出強化型の高強度銅合金として知られるCu-Ni-Si系合金に着目して研究を行った結果,以下に示す

知見を得ることができた。

【0010】本発明は、(1)添加元素の成分を、質量 割合にて、Ni:1%~4.8%, Si:0.2%~1.4%と し、Siに対するNiの含有量比が2~8になるように調 整し、残部を実質的に銅及び不可避不純物とし、引張強 さが650MPa以上、介在物の大きさが10μm以下であり、 かつ5~10μmの大きさの介在物個数が圧延平行断面で50 個/mm²以下であり、さらにポリイミドと熱圧着する際の 加熱条件に相当する330°C,2時間の加熱前後における熱 伸縮率△を

 Δ (%) = (1-1,) /1,×100

1。: 加熱前の試料長さ, 1: 加熱後の試料長さ としたとき、圧延平行方向に対して△が-0.1%~+0.1% であるハードディスクドライブサスペンション用銅合金 箔、及び(2)添加元素の成分を、質量割合にて、N $i:1\%\sim4.8\%$, S $i:0.2\%\sim1.4\%$, Mg, Zn, Sn, F e. Ti, Zr, Cr, Al, Mn, AgおよびBeの1種以上を総量で 0.005~2%とし、Si に対するNi の含有量比が2~8に なるように調整し、残部を銅及び不可避不純物とし、引 張強さが650MPa以上、介在物の大きさが10μm以下であ り、かつ5~10µmの大きさの介在物個数が圧延平行断面 で50個/mm²以下であり、さらにポリイミドと熱圧着する 際の加熱に相当する330°C, 2時間の加熱前後における熱 伸縮率△を

 Δ (%) = (1-1,) /1, ×100

1。: 加熱前の試料長さ, 1: 加熱後の試料長さ としたとき、圧延平行方向に対して△が-0.1%~+0.1% であるハードディスクドライブサスペンション用銅合金 箔に関するものである。上記(1)または(2)におい て、ポリイミドと熱圧着する際の加熱に相当する330 °C、2時間の加熱前後における熱伸縮率△は、上記した 圧延平行方向の範囲に加えて、圧延直角方向の前記熱伸 縮率△が-0.02%~+0.04%を満足することが好ましい。 [0011]

【作用】(熱伸縮率)先述のように、銅合金箔加熱冷却 時の非可逆的熱伸縮は圧延中の母材の変形時に導入され た格子欠陥が、加熱により消失する過程で引き起とされ る。一方、ポリイミド、ステンレス鋼などの層構成材料 の熱伸縮とマッチングするような寸法変化特性を銅合金 箔がもつ必要があり、これによってさらに良好なサスペ ンション形状が得られる。具体的には、ポリイミドと熱 圧着する際の条件に相当する330℃、2hの加熱前後にお ける圧延方向の寸法変化△を

 $\Delta (\%) = (1-1_0) / 1_0 \times 100$

40

1。: 加熱前の試料長さ, 1: 加熱後の試料長さ としたとき、圧延平行方向に対して△が-0.1%~+0.1%と すればよい。寸法変化△が-0.1%未満であると、銅 合金箔が大きく収縮するために、冷却後の銅合金箔は引 張り歪を受け、一方ステンレス鋼及びポリイミドは圧縮 50 歪を受ける。この状態で三層積層体の歪がバランスして



特開2002-317231

いると反りは起とらない。しかし、上記したエッチング により何れかの層が除去されると、反りが発生する。次 に、寸法変化△が+0.1%より大きくなると、上記場 合とは反対の歪が発生し、やはりエッチング後に反りが 起こる。したがって、寸法変化 Δ は-0. $1\sim+0$. 1%の範囲にコントロールする必要がある。

【0012】圧延により材料に導入される格子欠陥の配 列に方向性があるため、寸法変化は圧延平行方向と直角 方向で異なる挙動を示す。かつ圧延直角方向で△が-0.0 2%~+0.04%の範囲にコントロールする必要がある。

【0013】 このような寸法変化特性を得るためには、 最終圧延の加工度を規定し、およびその後、条件を調整 した歪取焼鈍を行えばよい。最終圧延の加工度が高くな ると、寸法変化の原因となる格子欠陥が大量に導入さ れ、その後歪取焼鈍を行っても寸法変化を要求される範 囲に制御することができない。良好な寸法変化を得るた めの加工度は95%以下である。さらに最終圧延後に行う 歪取焼鈍においては、焼鈍温度を200~400℃、好ましく は250~350℃、焼鈍時間を30分~5時間、好ましくは1~ 4時間とすればよい。

【0014】(合金組成一NiおよびSi) NiおよびSiは、それ ぞれ合金中に固溶することによって合金の強度を高める 作用もあるが,適当な時効処理を行うことにより,Niと Siが相互にNi, Si組成の析出物を形成し、合金の強度を 著しく増加させるとともに電気伝導度も著しく高める。 ただし、Ni含有量が1%(組成を表す百分率は特記しな い限り質量%である)未満またはSi含有量が0.2%未満 の場合は、他の成分の複合添加を伴っても所望とする強 度が得られない。またNi含有量が4.8%を超えるかまた はSi含有量が1.4%を超える場合は導電率の低下が著し く、さらには強度の向上に寄与しない粗大なNiーSi粒子 が母材中に生成し、圧延後の破断、ピンホール発生等に より生産性の低下を招くことになる。従って、Niの含有 量を1~4.8%, Siの含有量を0.2~1.4%と定めた。更 に、時効処理後の電気伝導性をより高めるためには、合 金中のNiとSiの含有原子比率を化学量論組成のNizSiの 原子比率に近づけることが望ましい。良好な電気伝導性 を得るためのSi含有量に対するNi含有量の比(Ni含有量 /Si含有量)は2から8が良く、4が最も好ましい。

【0015】(合金組成—Mg, Zn, Sn, Fe, Ti, Zr, C r, Al, Mn, AgまたはBe) これらの成分はいずれも、Ni -Si系銅合金の強度を改善する作用がある。またこれ **らの中で,2mには半田接合部の耐熱性を改善する効果** もあり、Feには組織を微細化する効果もある. 更にM g, Ti, Zr, Al, Mnは熱間圧延性を改善する効 果も有する。との効果は、これらの元素が硫黄との親和 性が強いため、硫黄と化合物を形成し、熱間圧延割れの 原因となるインゴット粒界への硫黄の偏析を軽減するた めである。Mg, Zn, Sn, Fe, Ti, Zr, Cr, Al, Mn, Agま たはBeの含有量が総量で0.005%未満であると上記効果

は得られず、一方総含有量が2%を超えると電気伝導性 が著しく低下する。そこでこれらの含有量を0.005~2% と定める。

【0016】(引張強さ) 箔の折れや変形が生じないよ うに650MPa以上の引張り強さが必要である。また、 引張り強さは方向性はほとんどないが、圧延方向に対し て平行方向および直角方向の何れの試験片についても上 記値を満足する必要がある。

【0017】(介在物)本発明における「介在物」と 10 は、Cu-Ni-Si系合金における鋳造時の凝固過程 以降、即ち凝固後の冷却過程、熱間圧延後の冷却過程お よび時効焼鈍時に固相のマトリックス中に析出反応で生 じる析出物、鋳造時の凝固過程の偏析により生じ一般に 粗大である晶出物ならびに溶解時の溶湯内での反応によ り生じる不純物である酸化物、硫化物など、本合金のSE M観察によりマトリックス中に観察される粒子を包括す るものとして使用する。「介在物の大きさ」は介在物を SEM観察下でのその介在物を含む最小円の直径をいう。 「介在物の個数」とは、材料の圧延平行断面をエッチン 20 グ後SEM観察により、多数箇所において実際に数えた単 位平方㎜当たりの介在物個数である。この合金に必要な 強度を得るための介在物は小さいが、10μmを超える粗 大な介在物は強度に寄与しないばかりか、特に粗大な介 在物はエッチング性を低下させ、更には圧延工程におい て破断やピンホールの原因となり、生産性を著しく低下 させる。このような不具合を起こさないためには、この 粗大な介在物の大きさの上限を10µmとし、圧延平行断 面における5~10µmの大きさの介在物個数を50個/mm² 未満とすればよい。以下、実施例により本発明を詳しく 説明する。

【0018】 (実施例) 高周波溶解炉にて表1に示す各 種成分組成の銅合金を溶製し、厚さが20mmのインゴット を鋳造した。次にこのインゴットを800℃~950℃で厚さ 8mmまで熱間圧延を行い、表面のスケールを除去するた めの面削を施した後、冷間圧延により厚さ1mmの板と した。その後、800℃~950℃の温度で10分間溶体化処理 を行った後、最終冷間圧延の加工度を調節できるように 所定厚さまで冷間圧延した。そして更に、400°C~600°C で5時間時効を行った後、最終冷間圧延で厚さ0.018mm 40 の箔とし、150~500℃の範囲で1時間の歪取焼鈍を行っ

【0019】各合金箔について「強度」、「導電性」、 「寸法変化」,「介在物」を評価した。「強度」は引張 試験で引張強さを測定した。「導電性」は導電率によっ て示した。「熱伸縮率」については、圧延平行方向およ び圧延直角方向を長手方向として150×12.7mmの試料を 切り出した後、所定位置のマーキング間の距離を3次元 座標測定装置を用いて測定し、最低300℃、最高330℃の 温度で最短で1時間、最長で2時間加熱した後再度マー 50 キング間距離を測定し、加熱前後の寸法の測定値から寸



法の変化率を測定した。測定値のばらつきは上記温度及び時間範囲内では測定誤差内に収まった。「介在物」については,試料の表面を鏡面研磨した後,SEMにて5000倍の倍率で,1平方mm当たりの5μm以上の大きさの介在物数を測定した。さらに厚さ0.018mm,幅450mm,長さ5000mの箔を作製し,生産性の評価を行った。「生産性」は圧延工程中の破断発生状況および製品段階での*

* ピンホール発生状況で評価した。「破断」については、 破断が発生しなかった場合を〇、破断した場合を×とした。「ピンホール」については1000m当たりの直径0.5 mm以上のピンホール発生個数を計測した。

[0020]

【表1】

							化学员	Ì分(wt	.%)						Ni/Si	最終圧延	绘鲍温度
	No.	Ni	Si	Mg	Zn	Ba	Fe	Ti	Zz	Cr	Al	Mn	Ag	Be	比	加工皮(%)	(×1hr)
	1	2.46	0.59	-	· -		-		· ·	1 .	-				4.2	94	800
	2	2,72	0.61	0.15	-						•		•	•	4.5	94	850
	3	2.55	0.53	·	0.42	-	·		0.050	·	•	•	•		4.8	94	360
	4	2.61	0.78		-	0.64		·			0.82			-	3.6	94	400
	5	2.05	0.48	\vdash	0.88	-	1.02	·			•	•	-	•	4.8	94	.400
*	6	8.16	0.78		-	•		0.64	•		0.42			•	4.1_	94	300
発	7	2.89	0.72			•	-		1.82	1	-	•	- 1	-	4.0	94	850
明	8	2.63	0.81	•	·	•	•	•		1.12	•		0.032	-	3.2	94	350
	9	1.87	0.46			-		0.084		T	0.84			•	4.1	94	300
A	10	2.66	0.57	· ·		0.51	•	•	· ·		•	0.61		•	4.7_	94	250
Œ	11	2.11	0.40			-		· .	0.88			•	0.78		5.8	94	300
	12	2.31	0.82			_ ·	·				•	•		0.59	2.8	.94	300
	13	2.62	0.61	· ·	0.94		•	•			-	0.03	0.02	•	4.3	89	400
	14	2.35	0.55		0.68	•	•	•				•			4.8	92	400
	15	2.0ŏ	0.44	0.11	0.47	0.49	-	·						•	4.7	89	360
	16,	2.85	0.76		1.16	0.45	-				•	-			8.8	88	800
	1	0.86	0.78	•	-	-	-	0.54		•	-	•	·	•	1.1	94	300
	2	2.65	2.11			1.11	-	•			•	0.05		•	1.2	94	350
比	3	2.33	0.46	1.26		1.86	-	·	0.56	-		•	•		5.1	94	400
Ø	4	8.25	1.02		0.11		0.64			-	0.33	-			8.2	94	500
습	5	2.32	1.11	•	•	-	-	· ·	•	0.06		-			2.1	94	150
æ	8	2.88	0.62	•			-								4.2	97	300
	7	4.98	0.69			••	•		•		•		•		7.2	92	350
	8	2,42	0.14		· ·	0.21	•	· ·	· -	·	•		· ·		17.8	90	400
红	##		タフピッチ四								T -	89	180				

【0021】表2に評価結果を示す。本発明合金と比較すると比較合金1はNiが低いために強度が劣る。比較合金2は、Siが高いために導電率が劣る。比較合金3は本発明の含有量範囲を超えて副成分を含有するため導電率が劣る。比較合金4は歪取焼鈍温度が高いため強度が劣り、比較合金5は、歪取焼鈍温度が低いため、加熱による寸法変化が大きくなった。比較例2,4,5では介在物個数が多いために製造工程中で破断が発生し、ピンホールの

30 個数が増加した例である。比較合金6では最終圧延の加工度が大きいために直角方向の寸法変化が大きくなった例である。また比較例7はNi含有量が適正範囲を超えているため導電率が低下しまた介在物数が増加し破断、ピンポールの増加を引き起こした例である。比較合金8はSi含有量が少ないために強度が低下した例である。【0022】

【表2】

विश्वसं 2

表 2	本発明合金およ	び比較例の特性野価結果

	.	引張強さ	等理率 (%IACS)	热伸縮率(%)		介在物個数	破断の有無	ピンホール発生器	
r	lo.	(N/mm ³)		圧延平行方向	正弧直角方向	何/mm²	MCKA V2 73 ATR	₩/1000m	
	ī	809	53	0.018	0.011	6	0	3	
	2	822	51	0.009	0.008	8	0	4	
	3	789	51	0.007	0.009	ō	0	4	
-	4	811	48	0.008	0.002	15	0	6	
1	5	813	49	0.002	0.001	18	0	2	
*	6	799	48	0.018	0.010	24		7	
実	7	768	48	0.002	0.006	27	0	8	
発	8	744	50	0.002	0.007	31	0	9	
明	9	781	52	0.014	0.011	7	0	4	
合	10	810	48	0.045	0.016	16	0	6	
仑	11	746	58	0.028	0.012	11	0	5	
	12	803	57	0.022	0.014	41	0	12	
	13	810	46	0.002	0.003	18	0	7	
	14	790	50	0.005	0.002	10	Q	5	
	15	790	47	0.018	0.008	21	0	5	
	16	810	44	0.020	0.011	10	0	3	
	1	437	32	0.010	0.018	3	0	2	
	2	814	25	0.008	0.009	77	×	18	
HŁ.	8	713	27	0.015	0.002	41	0	13	
較	4	602	88	0.006	0.001	68	×	21	
A	5	788	45	0.112	0.016	55	×	17	
슢	В	820	50	0.034	-0.024	9	0	5	
	7	840	28	0.008	0.010	54	×	18	
	В	- 520	55	0.004	0.002	17	_ 0 _	5	
er:	集材	372	97	0.018	0.010		0	2	

[0023]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、従来に比べて、強度、導電性に優れ、加熱による寸法変化が少なく、介在物による加工精度の低下のない、ハードディスクドライブサスペンションの配線に好適な銅合金箔が得られる。

【図面の簡単な説明】

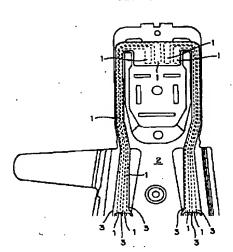
*【図1】 ハードディスクサスペンションの一例を示す 平面図である。

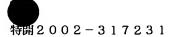
【符号の説明】

- 1 銅合金箔
- 2-サスペンション
- 3-樹脂

*

【図1】





フロントページの続き

(72)発明者 江良 尚彦

茨城県日立市白銀町一丁目1番2号 日鉱 金属株式会社技術開発センター内 Fターム(参考) 5D042 NA01 PA10 TA07

5D059 AA01 BA01 CA08 CA29 DA33

DA36 EA08

5G301 AA01 AA03 AA04 AA07 AA08

AA09 AA12 AA13 AA14 AA19

AA20 AA21 AA23 AA24 AB02

AB20 AD10